(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-195713

(43)公開日 平成6年(1994)7月15日

(51)IntCl. ⁵		識別記号	庁内整理番号	FI.	•	技術表示箇所
G 1 1 B	7/00	· L	7522-5D		• •	•
•	7/125	С	7247—5D	•	•	
	11/10	Z	9075-5D			

審査請求 未請求 請求項の数8(全 9 頁)

(21)出願番号	特願平4-347689		(71)出願人	000005108	
			•	株式会社日立製作所	
(22)出願日	平成 4年(1992)12月28日		•	東京都千代田区神田駿河台四丁目 6番地	
			(72)発明者	戸田 剛	
				東京都国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地	
•			•	株式会社日立製作所中央研究所内	
			(72)発明者	井手 浩	
			•	東京都国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地	
•				株式会社日立製作所中央研究所内	
			(72)発明者	前田 武志	
				東京都国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地	
				株式会社日立製作所中央研究所内	
* * .			(74)代理人	弁理士 小川 勝男	
		• •	. •	最終頁に続く	

(54) 【発明の名称】 光記録の記録方法

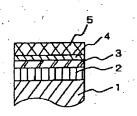
(57)【要約】

【目的】 本発明の目的は、ディスクローディング時等にディスクへ一定のパターンを記録し、それを再生して、その結果を用いて記録制御することにより、高密度記録を実現すると共に、異なるディスク間の互換性を確保することにある。

【構成】 本発明は、光磁気記録ディスクの熱的特性を主に評価できるパターンを用いてディスクローディング時にそのパターンを用いてテスト記録を行い、その結果をもとに用いるディスクに合った記録条件を見出す手法を有する。

【効果】 本発明により、超高密度光記録を実現できると共に、異なる特性を有するディスクに対しても高精度な記録制御が可能であり、ディスク間の互換性が確保できる。

図



1・・・基板

3 *** 情報記錄價 4 *** 無機化合物層

2

【特許請求の範囲】

【請求項1】少なくともレーザー光を用いて記録、再生、或いは、消去を行う光記録において、異なる記録媒体を用いても、常に、同じマーク形状が得られるように、ユーザーのデータを記録するのに先立って、テスト記録を行なうことにより、ディスクへの最適な記録条件を見出すために一定のデータパターンをディスクへ記録を行った後に再生を行い、その結果をもとにユーザーデータの記録のバルス幅もしくはレーザーパワーの少なくとも一方の値を制御したことを特徴とする光記録の記録 10 方法。

【請求項2】請求項1記載のディスクへデータを記録するのに少なくともマーク長記録方式を用いて記録を行なったことを特徴とする光記録の記録方法。

【請求項3】請求項1~2記載のディスクへの最適な記 録条件を見出すために用いる一定のデータパターンとし て、或るトラックの基準となる位置に用いる変調方式に 応じた一定のパルスを発生させディスクヘドメインを形 成し、このドメインを基準としてその位置から熱的干渉 のない一定距離離れた位置に、用いる変調方式に対応し 20 た一定のパルスを発生させディスクへ第2のドメインを 記録し、このドメインとドメインの間のギャップ部分を 基準のクロックとして用い、さらにその位置から一定距 離離れた位置に変調方式に応じた一定のパルスを発生さ せディスクへ第3のドメインを記録し、そこからある距 離離れた位置に用いる変調方式に応じた一定のパルスを 発生させディスクへ第4のドメインを記録し、記録した ドメインを再生して少なくとも第3と第4のドメインの 間の距離を測定し、その結果をもとにユーザーデータの 記録のパルス幅もしくはレーザーパワーの少なくとも一 30 方の値を制御したことを特徴とする光記録の記録方法。

【請求項4】請求項1~3記載のディスクへ記録したテストバターンにおいて、記録したドメインを再生を行ない、第3と第4のドメインの間の距離及び第4のドメインの長さを測定し、その結果をもとにユーザーデータの記録のバルス幅もしくはレーザーバワーの少なくとも一方の値を制御したことを特徴とする光記録の記録方法。

【請求項5】請求項1~4記載のディスクへ記録するテストパターンにおいて、第3のドメインと第4のドメイン間の距離を用いる変調方式に応じて距離を変えて記録 40を行ない、第3と第4のドメインの間の距離及び第4のドメインの長さを測定し、その結果をもとにユーザーデータの記録のパルス幅もしくはレーザーパワーの少なくとも一方の値を制御したことを特徴とする光記録の記録方法。

【請求項6】請求項1~4記載のディスクへ記録するテストパターンにおいて、第3のドメインと第4のドメイン間の距離を用いる変調方式に応じて距離を変えて記録を行ない、記録したドメインを再生して少なくとも第3と第4のドメインの間の距離を測定し、その結果をもと 50

にユーザーデータの記録のパルス幅もしくはレーザーパワーの少なくとも一方の値を制御したことを特徴とする 光記録の記録方法。

【請求項7】請求項1~6記載のディスクへ一定のテストパターンを記録するのに、記録レーザーパワーを変化させて記録を行ない、記録したデータを再生して、データパターンによらず一定の信号振幅が得られるようにユーザーデータの記録のパルス幅もしくはレーザーパワーの少なくとも一方の値を制御したことを特徴とする光記録の記録方法。

【請求項8】請求項1~7記載のディスクへ一定のテストパターンを記録するのに、用いるレーザーパルスの形状として、微小のパルスから構成される記録波形を用いて記録したことを特徴とする光記録の記録方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、レーザー光を用いて記録、再生、或いは消去を行う光記録に係り、特に、ディスク間の互換性を確保するのに有効な光記録における記録方法に関する。

[0002]

【従来の技術】近年の高度情報化社会の進展に伴い高密度でしかも大容量なファイルメモリーへのニーズが高まっている。これに応えるものとして、光記録が注目されている。これまでの再生専用型、及び、情報が1度だけ記録できる追記型に加えて、最近では書換え型の光ディスクが実用化され、それぞれの特徴を生かした分野で広く用いられるようになってきた。ところで、光ディスクは可換媒体であることがら媒体間の互換性、又は、装置間の互換性を確保することがより使いやすいシステムであるといえる。この場合、重要なのは如何なるディスクに対しても同一の記録ができることで、特に、高密度記録を実現するためには重要な課題である。ところで、書換え型光ディスクのなかで、最も早く実用化された光磁気ディスクは最適記録パワーや消去パワーをはじめとする記録条件がディスクごとに異なっている。

【0003】この記録条件の相異を解消するため、記録 媒体側では次のような工夫がされていた。ISO規格に予 め記録条件などをディスクのコントロールトラックへ記 録する点を規定し、ディスク間の互換性の確保に努めて いる。また、使用する装置に対して、予めパワー較正用 の基準ディスクを準備し、そのディスクとの相対比較に よりパワーが定められたディスクを作製するしていた。

【0004】一方、データの記録方式としてマーク長記録方式を用いて記録を行なう場合、信号制御でマークエッジの位置ずれ補正をしている。特に、記録媒体内を流れる熱流および光磁気記録の場合は磁気特性の制御は、マークエッジの位置ずれに大きな影響を与える。マーク長記録においては、形成されるマークの長さによって情報を記録するため、マークエッジの位置ずれは、高密度

3

記録、高精度記録に直接関連するのである。このマークエッジの位置ずれに影響されないで情報を記録し、再生する例に、特開昭4-265522号がある。これは、初期動作としてディスク上に一定のパターンを記録しそのパターンを再生してエッジの位置ずれを検出し、そのずれ量に基づいて、情報再生信号をシフトするものである。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】上述の従来技術によれば、互換性を実現するための手法は、記録媒体側、装置側で提案されている。しかし、装置にとって、不特定の記録条件の記録媒体を扱うことは、記録または再生時の誤差信号をある程度許容しなくてはならない。従って、記録媒体の記録密度を向上させると、上記誤差信号の許容範囲が狭くなってしまい、互換性のある記録媒体で高密度記録を達成することは困難になってくる。特に、マーク長記録を用いて、トラックピッチをつめたりピットピッチをつめて記録する場合には、ピット間の熱干渉の影響が大きく、互換性が保てない。これは、ディスクの熱的特性が異なるため、形成されるマーク形状の制御性、特に、制御精度が異なることに基づく。

【0006】従って本発明の目的は、記録媒体によらず 正確な情報の記録又は再生を行うために最適な記録パル ス形状を提供することにある。

[0007]

【課題を解決するための手段】少なくともレーザー光を用いて記録、再生、或いは、消去を行う光記録において、異なる記録媒体を用いても、常に、同じマーク形状が得られるように、ユーザーのデータを記録するのに先立って、テスト記録を行なうことにより、ディスクへの最適な記録条件を見出すために一定のデータパターンをディスクへ記録を行った後に再生を行い、その結果をもとにユーザーデータの記録のパルス幅もしくはレーザーパワーの少なくとも一方の値を制御したことを特徴とする光記録の記録方法。

[0008]

【作用】本発明では、少なくともレーザー光を用いて記録、再生、或いは、消去を行う光記録において、異なる記録媒体を用いても、常に、所定の条件を満足するマーク形状が得られる。ユーザーのデータを記録するのに先40立って、デスト記録を行なうことにより、ディスクへの最適な記録パルス形状を見出すために一定のデータパターンをディスクへ記録を行った後にそのデータパターンを再生し、その結果をもとにユーザーデータの記録のパルス幅もしくはレーザーパワーの少なくとも一方の値を制御することによる。

【0009】例えば、マーク長記録方式においては、ディスク上に形成されるマーク (ドメイン) の幅と長さを高精度に制御する必要がある。その場合、重要なのは、情報を有するマークエッジの立上り、立下りの位置ずれ

を制御する点である。光ディスクの記録原理上、熱とデ ィスクとは密接な関係があり、ディスクに与えられる熱 を制御することは、記録精度に大きな影響を与える。し かしこれらの熱特性は、ディスクにより異なっているの で、ディスクによって、記録条件も異なる。そこで本発 明では、ディスクローディング時等に一定のテストパタ ーンによりディスクの記録特性を評価し、その結果を用 いてディスクへの記録条件を決定する。ディスクへの最 適な記録条件を見出すために用いる一定のデータパター ンとして、任意のトラックの基準となる位置に用いる変 調方式に応じた一定のパルスを発生させディスクヘドメ インを形成し、このドメインを基準としてその位置から 熱的干渉のない一定距離離れた位置に、用いる変調方式 に対応した一定のバルスを発生させディスクへ第2のド メインを記録し、このドメインとドメインの間のギャッ プ部分を基準のクロックとして用い、さらにその位置か ら一定距離離れた位置に変調方式に応じた一定のパルス を発生させディスクへ第3のドメインを記録し、そこか らある距離離れた位置に用いる変調方式に応じた一定の パルスを発生させディスクへ第4のドメインを記録し、 記録したドメインを再生して少なくとも第3と第4のド メインの間の距離を測定し、その結果をもとにユーザー データの記録のパルス幅もしくはレーザーパワーの少な くとも一方の値を制御すればよい。ところで、ディスク へ記録したテストパターンにおいて、記録したドメイン を再生を行ない、第3と第4のドメインの間の距離及び 第4のドメインの長さを測定し、その結果をもとにユー ザーデータの記録のパルス幅もしくはレーザーパワーの 少なくとも一方の値を制御してもよい。また、ディスク へ記録するテストパターンにおいて、第3のドメインと 第4のドメイン間の距離を用いる変調方式に応じて距離 を変えて記録を行ない、記録したドメインを再生して少 なくとも第3と第4のドメインの間の距離を測定し、そ の結果をもとにユーザーデータの記録のパルス幅もしく はレーザーパワーの少なくとも一方の値を制御してもよ い。また、ディスクへ一定のテストパターンを記録する のに、記録レーザーパワーを変化させて記録を行ない、 記録したデータを再生して、データパターンによらずー 定の信号振幅が得られるようにユーザーデータの記録の パルス幅もしくはレーザーパワーの少なくとも一方の値 を制御してもよい。ところで、ディスクへ一定のテスト パターンを記録するのに、用いるレーザーパルスの形状 として、微小のパルスから構成される記録波形を用いて 記録することが好ましい。ここで用いる記録波形として は、微小のパルスから構成される記録波形に限らず、デ ータの記録に用いる波形と同一形状のものを用いればよ い。このようにして評価した結果を用いて決めた記録条 件を用いて記録することにより、いずれのディスクを用 いても、同一形状の磁区を形成することができ、高密度 記録を実現できる。この効果は、光磁気記録に限らず、

相変化型光ディスクや追記型光記録へも応用できること はいうまでもない。

【0010】このように一定パターンを用いて記録/再 生を行い、記録しようとするディスクに対して最適な記 録条件を見出すことにより、いかなるディスクを用いて も、同一形状の磁区を形成することができるので、ディ スクの互換性を確保できると共に、髙精度な磁区形状制 御が可能になるので、マーク長記録方式を可能にするの で、超高密度光記録を実現することができる。

[0011]

【実施例】本発明の詳細を実施例を用いて説明する。

【0012】本実施例に用いる光磁気ディスクの構造を 示す模式図例を図1に示す。ディスクは、基板(1)と してポリカーボネート等のプラスチック基板や紫外線硬 化型樹脂で凹凸の案内溝をガラス基板上に、無機化合物 層 (2) としてSiをターゲットに用いた反応性スパッタ 法により窒化シリコン膜を75 nm の膜厚に形成した。こ こで、膜の作製法は本発明により得られる効果に影響を 及ぼすものではない。次に、情報記録層(3)としてTb FeCo膜をスパッタ法により25 nm の膜厚に形成した。つ 20 づいて、無機化合物層(4)として窒化シリコン膜をSi をターゲットに用いた反応性スパッタ法により15 nm の 膜厚に形成した。そして、最後に、金属層(5)として AlseTi₄膜をスパッタ法により形成した。このようにし て作製した光磁気記録媒体全体を紫外線硬化型樹脂によ りコートした。

【0013】 (実施例) このようにして作製したディス クを用いて、ディスクローディング時にまずテスト記録 を行う。このディスクへ図2に示す記録パターンを用い て記録を行う。

【0014】この記録パターンは、すでに変調(例え ば、(1.7)RLL変調) されてあり、パルス幅、ギャップ幅 を図2中の数値にて示してある。これらの数値の1単位 は時間Twを示し、Twは、ディスクの回転が3000rpmの場 合、ディスクの最内周で約40nS、すなわちTw=40[ns]で

【0015】まず、図2 (a) の場合を用いて説明す

【0016】立上りEs、時間2Twの単パルスと、ギャッ プ15Twを狭んで立上りEu時間2Twの単パルスを発する。 これらの単パルスは、それ以前の記録状態の影響をなく すために設けられているものである。

【0017】こうして、以前の記録状態の影響のない基 準の状態を得た後に、時間8Twのギャップを経て、立上 りE1、立下りE2、時間2Twの単パルスalと、時間2Twのギ ャップ後、立上りEa、立下りEa、時間2Twの単パルスa2 を発生させる。

【0018】このような単パルスとギャップとの組合せ によって記録されたパターンを再生し、al、a2間のギャ ップ長と、立上り及び立下り位置のシフト量を測定した 50 イトクロックに同期している。また、記録パルス以外の

結果を図3に示す。

【0019】図3において、図2 (a) のal、a2間のギ ャップ量に対応する点は、ギャップ量2Twであることか ら、横軸80nsの点である。縦軸Tr-Twは、記録と再生で のエッジ位置 (E1、E2、E3、E4) ずれ時間を示してい る。すなわち、記録エッジ位置と等しい再生エッジ位置 であれば、Tr-Tw=0、再生エッジ位置が記録エッジ位置 よりも早い時点に検出されればTr-Tw<0、再生エッジ位 置が記録エッジ位置よりも遅い時点に検出されれば、Tr 10 -Tw>0となる。

【0020】図3における測定結果を図2(a)のE1、 E2、E3、E4に照らし合わせてみると、単パルスa1、a2が 互いに影響しており、単パルスal、a2間のギャップが、 時間2Twを確保できない。

【0021】これは単パルスal、a2による熱によってギ ャップに必要以上の熱が加わることによる。再生時に見 かけ上熱の影響をなくした記録ピットを形成するため、 記録パルス形状を図2 (g) の形状とする。

【0022】すなわち、第1のパワーレベルPw (記録パ ワーレベル) に立ち上がってから3/2 Tw後に第2のパワ ーレベルPr(再生パワーレベル)へ戻り、Tw後、第3の パワーレベルPasを保持する。このPasは、Pwによ る隣接記録ピット間隔によらず熱干渉作用が一定とする ために与えられる補助パワーレベルである。

【0023】Pasの設定は、例えば、次のようにして 決める。単パルスを用いて図2 (a) の記録パターンを 記録し、そのパターンを再生すると、図3に示すエッジ 位置ずれ量を得ることができる。このエッジ位置ずれ量 に対応したPasのテーブルをあらかじめメモリ等に記 憶しておき、そこからTr-Tw値を最小にするPas値を 選択する。

【0024】他の方法には、ディスクの任意の位置に、 PrからPwまでの範囲でPasを変化させながら図2

(a) の記録パターンを複数個記録する。それらのパタ ーンを再生し、図3に準じてTr-Twを測定し、Tr-Twが最 小となるPasを選択する。

【0025】また、更に精度を上げるには、例えば、図 2 (b) ~ (f) の記録パターンを記録し、再生して、 図3を得、これに基づき、上述の方法によってPasを 40 求めてもよい。

【0026】次に、図2(g)に示す記録パルス形状で マーク長記録をする場合の実施例を示す。

【0027】マーク長記録では、記録パターン長が一定 でないため、特に記録パターン長の立ち下がり部分にお けるTr-Twに大きなバラツキを生じる。これを防ぐた め、図4 (h) に示す記録パルス構造とする。

【0028】例えばここで用いる記録パルスは、先頭パ ·ルスを60 ns として、以下、20 nsのギャップと20 ns のパルスの繰返しである。この繰返しのパルス幅は、ラ

部分のパワーレベル P a s (補助光)は 2.9 mW とし、記 録パワーPwは 5.9 mW、そして、記録パルスの終了後 は、40 ns のリードパワーPrとした後に、再び、補助 光パワーPas(2.9 mW)とする。繰返しギャップ、繰 返しパルスの数は、記録パターンの長さに応じて加えら れる。変調方式には(1,7)RLL方式を用いた。

【0029】このような、図2(g)の記録パルス形状 で、ディスク上の任意の位置に、記録ドメインを記録す る。次に再生方式に、原波形スライス方式及び 2PLL を 用いて、記録ドメインを再生する。この再生回路を用い て、記録したい記録ドメイン長と再生の結果記録されて いるドメイン長との差 (Tr-Tw) をエッジシフトと定義 し、測定した結果を図6に示す。図6に示される様に、 マーク長記録において図4(h)の形状の記録パルスを 用いても、記録パターンの後部(図5 (a)~(g)に おけるE2部分)に、位置ずれの影響があることがわか る。記録パターン後部に対応する再生信号のエッジの位 置ずれを修正し、記録パターン長によらず、略一定の位 置ずれ量とするため、繰返しパルスのパワーレベルPw' を選択する。

【0030】その方法の概要は、図2のPasの選択方 法に類する。まずPw'=Pwとして、例えば図5 (b) の立 上りE1、立下りE2、時間2Twから8Twまでの記録パターン を図5 (h) の記録パルスで記録する。こうして記録さ れた記録ドメインは、前方のエッジ位置ずれよりも、後 方エッジ位置ずれを考慮しなければならない。 なぜな ら、Pwでドメインの記録後、パワーレベルをPrに下げ、 かつ、図5 (a) ~ (g) に示すように、E1、E2以前の 熱の影響を受けないようにギャップが設けられているか らである。前述のように図6では、立ち下がり部E2にお 30 けるエッジ位置ずれTr-Twを示す。これによれば、記録 パルス時間 (Tw=40ns) が長い程、エッジ位置ずれTr-Tw. が大きいことがわかる。

【0031】図6のエッジ位置ずれは記録パターンより も立下りE2が後方に長いドメインが形成されていること を示す。ドメインの後方エッジの延長は、記録パルス形 状の繰返しパルスレベル調整、又は、繰返しパルス数を 含めた記録パルス幅の制御により略一定の範囲内にする ことができる(図7参照)。

【0032】例えば図5 (i) に示すように、繰返しパ 40 ルスのパワーレベルをPw'<Pwとして、最適なPw'値を選 択する。Pw'の選択方法は、前述のPasの選択方法と 同様である。

【0033】このように、記録パルス形状及びパワーレ ベルを制御しない場合は、最大で 10 ns のエッジ位置 ずれであったものが、±2ns 以下であった。このことか ら、0.70μm幅で、0.75~3.0μm長の記録ドメインを安 定に形成でき、MCAV方式及びマーク長記録方式を併用す ることにより、5.25インチサイズで片面1GB程度の記録 容量を実現できた。そして、如何なる構造のディスクを 50 れ量で情報を記録することができ、超高密度光記録を実

用いても本発明の記録パターンを用いてテスト記録を行 うことにより、髙密度記録を維持したまま、ディスク間 の互換性を確保することができた。また、この効果は、 光磁気ディスクのタイプに依存することなく、例えば、 光強度変調オーバーライト型の光ディスクに対しても補 助光パワーを消去パワーへ置き換えるだけで、本実施例 と同様に対応できる。また、相変化型光ディスクに対し ても先の光強度変調オーバーライト型光ディスクの場合 と同様に対応できる。このテスト記録による記録制御以 外に、ディスク及びその駆動装置の使用環境温度の変動

【0034】次に、図2 (g) 及び図5 (h) に示す記 録パルス形状の基となる記録パターンの作成過程を、図 8の概念ブロック図と図9のタイムチャートを用いて説

を検出するために、テスト記録を行うことによりさらに

記録の制御性を向上させることができる。

【0035】図8の記録パターン形成手段6は、クロッ ク1とあらかじめ変調されたデータ2が入力され、まず 記録パワーレベルPwを有するべきパルス3、補助光パワ ーレベルPasを有するべきパルス4、繰返しパルスの パワーレベルPw'を有するべきパルス5を示すデジタル 信号が形成され、これらのデジタル信号が加算されて、 記録パターンを示すディジタル信号を得る。

【0036】パルス3、パルス4、パルス5の具体的な. 作成方法は、図9のタイムチャートに示される。図9 は、パルス幅2Twのデータと5Twのデータに対応したタイ ムチャートである。

【0037】 (a) のクロックと (b) のデータが入力 されると、(b) をTw/2遅らせて信号(c) とする。次 に、(c) と(b) のアンドをとって、信号(d) とす る。また信号 (d) を3Tw/2遅らせ(信号(e))、 (d) とのアンドをとり(信号 (f))、 (a) の否定 と(f)とのアンドをとる(信号(h))。

【0038】こうして、繰返しパルス5を示す信号 (h) を得ることができる。

【0039】また、信号(e)の否定(信号(c))と 信号(d)とのアンドをとり、記録パワーレベルPwを有 するべきパルス3を示す信号(j)を得ることができ

【0040】更に、(b) をTw遅らせた信号(k)と、 (b) の否定(信号(l)) とのアンドをとり(信号 (m) 、 (m) の否定 (信号 (n)) を得る。 (n) が、補助パワーレベルPasを有するべきパルス4を示 している。

【0041】以上の手法を用いるとパターン幅によらず 記録パターンを形成することができる。

[0042]

【発明の効果】本発明により、異なる特性を有する記録 媒体を用いても、記録ドメインによらず略一定の位置ず

現できる。更に、異なる特性を有するディスクに対して も高精度な記録位置制御が可能であり、ディスク間の互 換性をも確保できる。

【図面の簡単な説明】

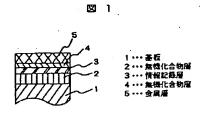
【図1】試作した光磁気ディスクの断面構造を示す模式図。

- 【図2】テスト記録パターン。
- 【図3】エッジシフトの測定結果。
- 【図4】エッジシフトの測定結果。

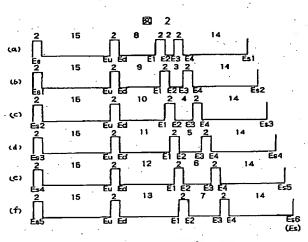
【図5】テスト記録パターン。

- 【図6】エッジシフトの測定結果。
- 【図7】エッジシフトの測定結果。
- 【図8】記録パターン形成手段の概念図。
- 【図9】本発明の記録単位パルスの作成概念図。 【符号の説明】
- 1…基板、2…無機化合物層、3…情報記録層、4…無機化合物層、5…金属層。

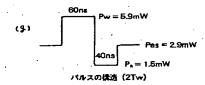
[図1]



[图2]

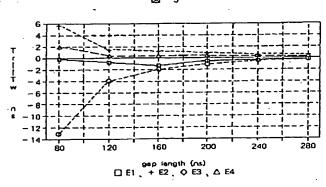


・ 図中の数値はTwを示す。 Twは、3000rpm 承内周で40ns である。



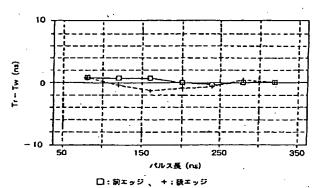
[図3]

⊠ 3

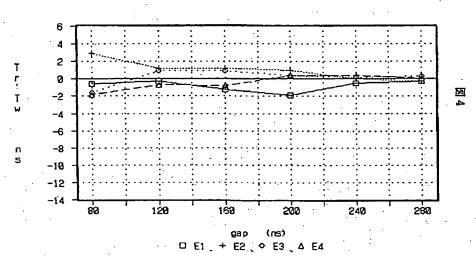


【図7】

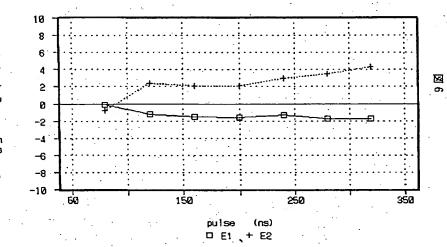
図 7



(図4)

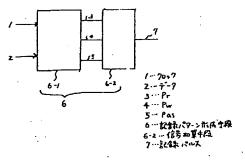


【図6】

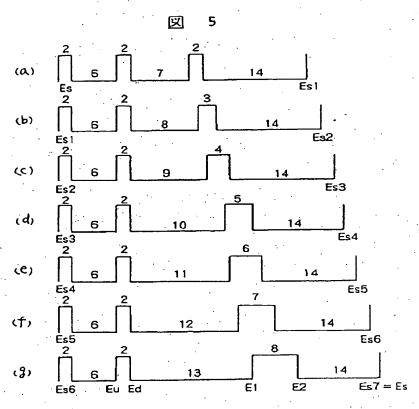


【図8】

E 8

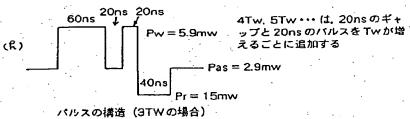


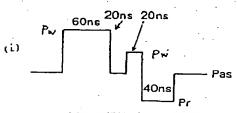




基準エッジ ; UU → Eu DD → Ed 注目するエッジ : E1, E2

図中の数値はTw を示す (Tw は, ここでは最内周(5.25 * r = 30mm) で 40ns である。

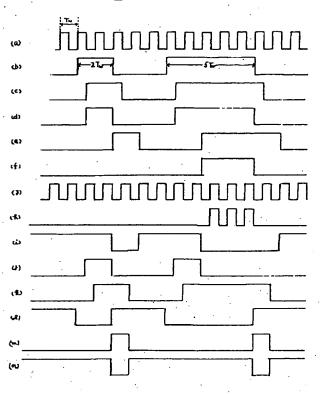




パルスの構造 (3TW の場合)

[図9]

(<u>V</u>) 9



フロントページの続き

(72) 発明者 桐野 文良

東京都国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製作所中央研究所内

(72)発明者 土永 浩之

東京都国分寺市東恋ケ窪 1 丁目280番地 株式会社日立製作所中央研究所内

(72)発明者 釘屋 文雄

東京都国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製作所中央研究所内